



X1	Кол-во мест	2	10	1	11	5	7	8	9	3	6	4	16	15	21	12	20	23	18	19	22	24	17	13	14		
	Цель	Изменение чистоты датчика	Датчик	Изменение чистоты датчика	Датчик	Зона нечистоты	Выключение инт. работы	Выключение инт. работы	-27В	Зона нечистоты	+27В	Обогрев		Охлаждение	Зона нечистоты	Выключение инт. работы	Зона нечистоты	Выключение инт. работы	Контроль	Контроль	Контроль						

Поз. обозначение	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
C16		K52-9-100В-100мкФ±10%-В		
		ОЖ0.464.213ТУ	1	
D1..D4		Диод 2Д102Б1/ББ		
		АЕЯР 4.32120.444ТУ	4	
D5		Стабилитрон 2С411А		
		аА0.339.550ТУ	1	
D8..D18		Диод 2Д102Б1/ББ		
		АЕЯР 4.32120.444ТУ	11	
D19		Стабилитрон ДВ16А		
		УЖЗ.362.027ТУ	1	
D21..D22		Диод 2Д2997А		
		аА0.339.452ТУ	2	
D23..D25		Диод 2Д212А/С0		
		АЕЯР 4.32120.177ТУ	3	
T1		Микросхема 10КТ1Б		
		И63.365.003ТУ	1	
T2..T5		Транзистор 2Т203Б		
		ЩЫЗ.365.007ТУ	4	
T6		Транзистор 2Т208Л		
		ЮФЗ.365.035ТУ	1	
T7..T8		Транзистор 2Т880В		
		аА0.339.594ТУ	2	
T9..T10		Транзистор 2Т208Л		
		ЮФЗ.365.035ТУ	2	
T11		Транзистор 2Т825В		
		аА0.339.054ТУ	1	
P1..P4		Реле РЭС34 РС4.524.370-01.03		
		РС0.459.001ТУ	4	
Tr1		Трансформатор тороидальный	1	
X1		Вилка 2РМДТ30Б24Ш5В1В		
		ГЕ0.364.126ТУ	1	

Поз. обозначение	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
R1		Сопротивление манганин	1	(99,05±0,1)Ом
R2		Сопротивление манганин	1	(198,1±0,2)Ом
R3		С2-33Н-0,5-100 Ом±10%	1	
R4		Сопротивление манганин	1	(10,80±0,01)Ом
R5		С2-33Н-0,5-510 Ом±5%	1	
R6		С2-33Н-0,5-1,5 МОм±10%	1	
R7*		С2-33Н-0,5-5,6 кОм±10%	1	Подбор(1,5-8,2)кОм
R8		С2-33Н-0,5-10 кОм±10%	1	
R9		С2-33Н-0,5-33 кОм±10%	1	
R10,R11		С2-33Н-0,5-10 кОм±10%	2	
R12		С2-33Н-0,5-4,7 кОм±10%	1	
R13*,R14*		С2-33Н-0,5-180 кОм±5%	2	Подбор(68-270)кОм
R15*,R16*		С2-33Н-0,5-47 кОм±5%	2	Подбор(10-68)кОм
R17,R18		С2-33Н-0,5-3,3 кОм±10%	2	
R20*,R21*		С2-33Н-0,5- 270 кОм±10%	2	Подбор(47кОм-1МОм) 430 кОм ±5%
R22*		Сопротивление медное	1	Подбор(50-100)Ом точность намотки 1%
R23		С2-33Н-0,5-30 кОм±10%	1	
R25*		С2-33Н-0,5-68 кОм±5%	1	Подбор(47-100)кОм
R26		С2-33Н-1-390 Ом±10%	1	
R27*,R28*		С2-33Н-0,5-39 кОм±10%	2	Подбор(27-100)кОм
R29		С2-33Н-0,5-510 Ом±5%	1	
R30		С2-33Н-0,5-1 кОм±10%	1	
R31,R32		С2-33Н-0,5-6,8 кОм±10%	2	
R33		С2-33Н-0,5-3,3 кОм±10%	1	
R34		С2-33Н-0,5-100 Ом±10%	1	
R35		С2-33Н-0,5-27 Ом±10%	1	
R38*		С2-33Н-0,5-68 Ом±10%	1	Подбор(24-200)Ом
R40		С2-33Н-0,5-18 кОм±10%	1	
R41*		С2-33Н-0,5-3 кОм±5%	1	Подбор(2,0-5,1)кОм
R42		С2-33Н-0,5-56 кОм±10%	1	
R43,R44		С2-33Н-0,5-15 кОм±10%	2	
R45*,R46*		С2-33Н-0,5-750 Ом±5%	2	Подбор 470 Ом-2,2 кОм
R47		Сопротивление манганин	1	(99,05±0,1)Ом
R48*		Сопротивление манганин	1	98,9..99,4)Ом подбор с доп. ± 0,1 Ом
R49		С2-33Н-0,5-200 Ом±5%	1	
R50,R51		С2-33Н- 1-27 Ом±10%	2	
R52,R53		С2-33Н-0,5-8,2 Ом±10%	2	
R56*		С2-33Н-0,5-51 кОм±5%	1	33,9кОм±5% по 1 МОм±10%
C1..C3		K52-9-63В-47мкФ±10%-В		
		ОЖ0.464.213ТУ	3	
C4		K10-47а-250В-4700нФ±10%-МПО		
		ОЖ0.460.174ТУ	1	
C5,C6		K52-9-50В-180мкФ±10%-В		
		ОЖ0.464.213ТУ	2	
C7		K10-47а-500В-1000нФ±10%-МПО		
		ОЖ0.460.174ТУ	1	
C8,C9		K52-9-63В-22мкФ±10%-В		
		ОЖ0.464.213ТУ	2	
C10		K52-9-50В-180мкФ±10%-В		
		ОЖ0.464.213ТУ	1	
C11..C15		K52-9-63В-22мкФ±10%-В		
		ОЖ0.464.213ТУ	5	

1. Резисторы С2-33Н по ОЖ0.467.093ТУ.
2. Резисторы, обозначенные *, подбирают при регулировании. Допускается устанавливать резисторы с допуском ±10%.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Блок управления автоматического регулятора температуры Схема электрическая принципиальная	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.								
Провер.								
Т.контр.								
Н.контр.								
Утверд.					Лист	Листов	1	